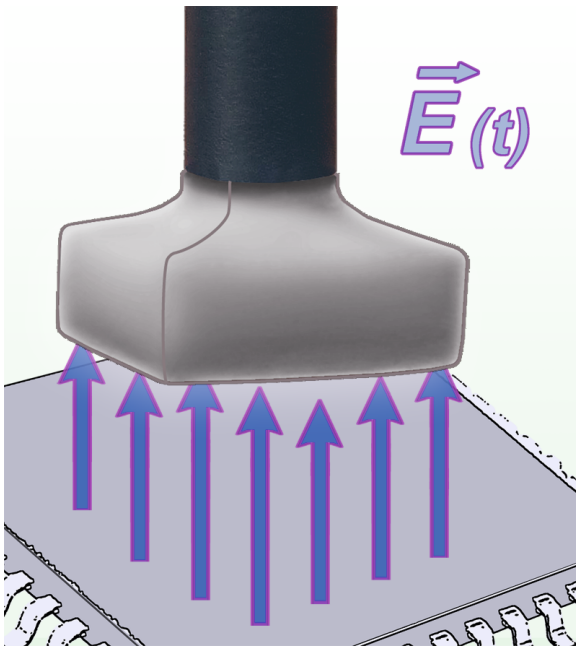


# XF-E 09s

E-Feldsonde 30 MHz bis 6 GHz



## Kurzbeschreibung

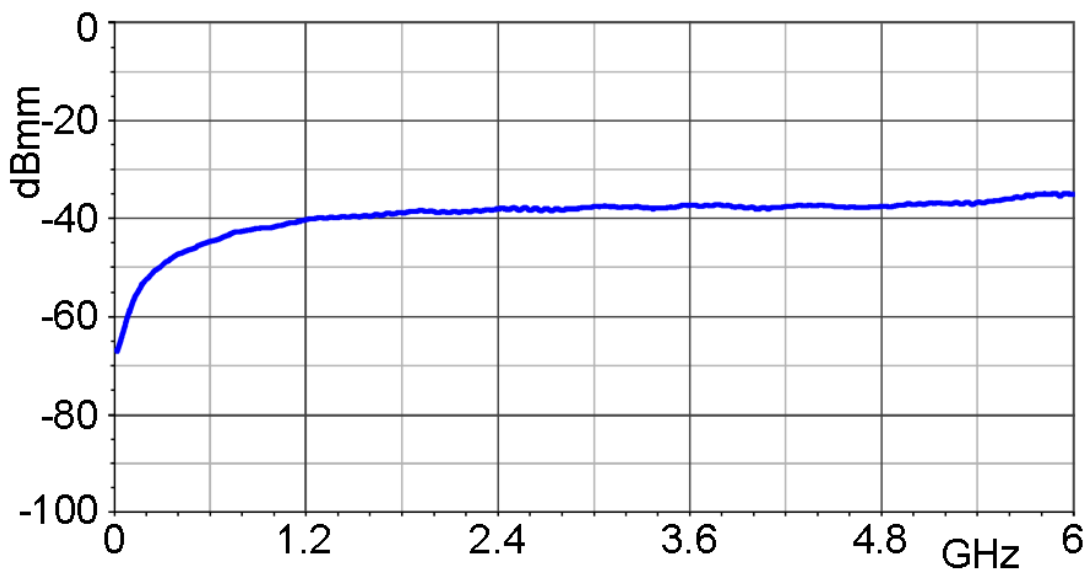
Die Nahfeldsonde erfasst die elektrischen Felder, die aus Messobjekten (ICs) auskoppeln. Die Flanken des Sondenkopfes sind geschirmt, so dass seitlich eintreffendes E-Feld nicht gemessen wird. Die Empfindlichkeit der Nahfeldsonde ermöglicht Messungen im Abstand von 0,5 mm bis 10 mm über IC's und Baugruppen.

Die XF-E 09s ist eine passive Nahfeldsonde. Sie besitzt den gleichen prinzipiellen Aufbau wie die Sonde XF-E 04s. Zur Messung wird die E-Feldsonde über die Bauelemente oder Bereiche der Flachbaugruppe geführt bzw. aufgesetzt. Die Oberseite und die Flanken des Sondenkopfes sind elektrisch geschirmt. Die E-Feldsonde hat eine Mantelstromdämpfung. Die Nahfeldsonde wird an einen Spektrumanalysator oder ein Oszilloskop mit 50  $\Omega$  Eingang angeschlossen. Die E-Feldsonde besitzt intern einen Abschlusswiderstand.

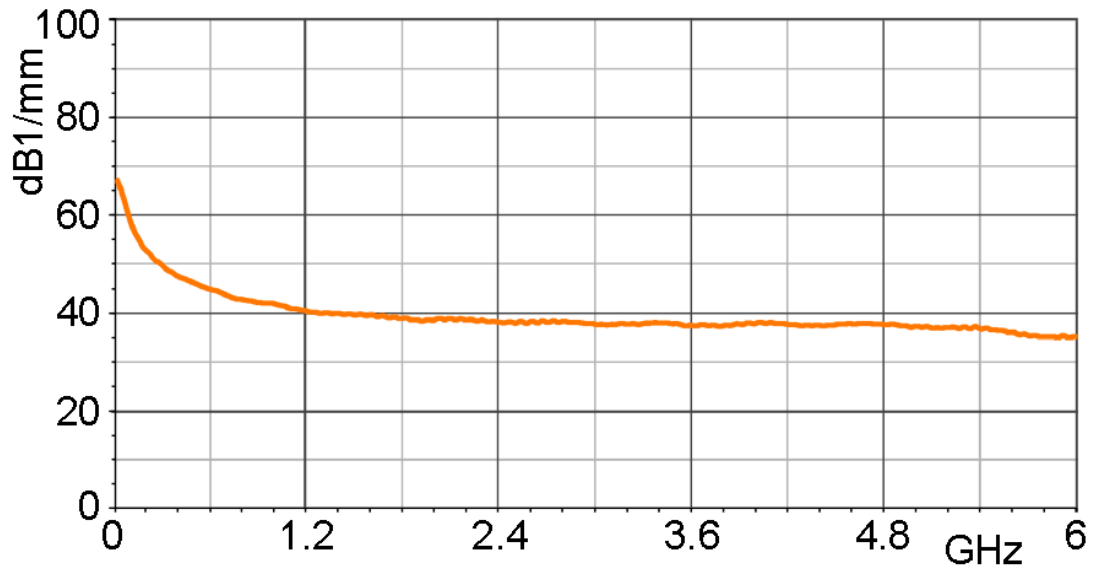
## Technische Parameter

Frequenzbereich	30 MHz ... 6 GHz
Maße Sondenkopf	$\approx (10 \times 10)$ mm
Anschluss - Ausgang	SMA, female, jack

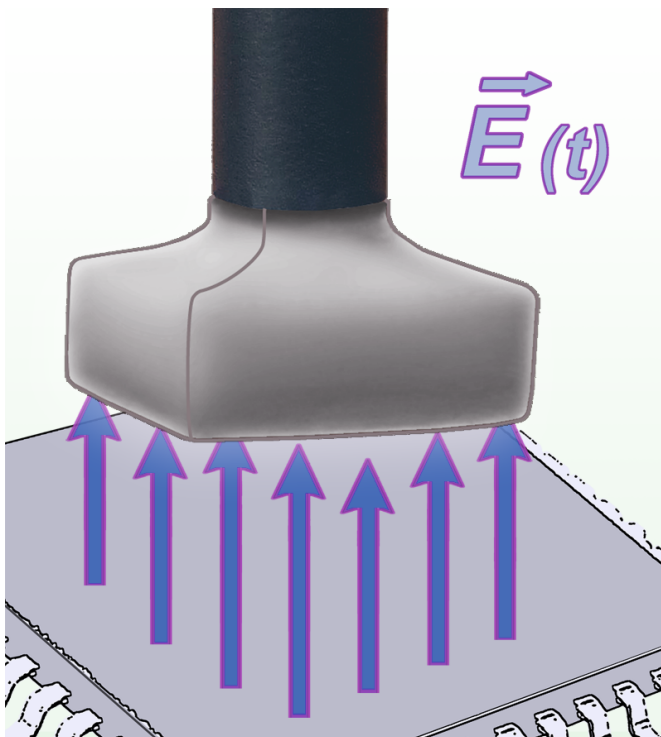
Frequenzgang [dB $\mu$ V] / [dB $\mu$ V/mm]



Korrekturkurve E-Feld [dB $\mu$ V/mm] / [dB $\mu$ V]



Messprinzip



# XF-E 09s

E-Feldsonde 30 MHz bis 6 GHz

Sondenkopf

